[A] TIIVISTELMÄ - SAMMANDRAG

SUOMI-FINLAND
(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

(11) (21) Patenttihakemus - Patentansökan 954942

(51) Kv.Ik.6 - Int.cl.6
H 01L 23/532, 21/768, C 23C 14/34

(22) Hakemispäivä - Ansökningsdag 17.10.95

(24) Alkupäivä - Löpdag 14.02.95

(41) Tullut julkiseksi - Blivit offentlig 24.11.95

(86) Kv. hakemus - Int. ansökan PCT/SE95/00152

(32) (33) (31) Etuoikeus - Prioritet
18.02.94 US 198354 P

(71) Hakija - Sökande
1. **Telefonaktiebolaget L M Ericsson**, 126 25 Stockholm, Sverige, (SE)

(72) Keksijä - Uppfinnare
1. **Hong, Sam-Hyo**, Solhagavägen 86, 163 60 Spånga, Sverige, (SE)

(74) Asiamies - Ombud: **Oy Kolster Ab**

(54) Keksinnön nimitys - Uppfinningens benämning

Radiotaajuusaktiivisesti metalloitua titaania, volframia ja kultaa sisältäviä sähkömigraatioresistantteja metallointirakenteita mikropiiriliitäntöjä varten
Elektromigrationsresistanta metalliseringskonstruktioner för mikrokretsförbindelser med radiofrekvensreaktivt metalliserat titan, wolfram och guld

(57) Tiivistelmä - Sammandrag

Keksintö koskee kahta mikropiirien keskinäiskytkentöihin tarkoitettua metallointijärjestelmää PtSi/TiW/TiW(N)/Au (tyyppi I) ja PtSi/TiW/TiW(N)/TiW/Au (tyyppi II) ja niihin liittyvää menetelmää. Näillä metallointijärjestelmillä ja tällä menetelmällä pystytään IC-keskinäiskytkentöihin, joissa metalliväli on niinkin pieni kuin 1,5 µm tai jopa pienempi. Nämä metallointijärjestelmät ovat luotettavia jatkuvien korkeassa lämpötilassa ja suurella virralla tehtävien operaatioiden yhteydessä.

Uppfinningen avser två metalliseringssystem avsedda för sammankopplingar i mikrokretsar PtSi/TiW/TiW(N)/Au (typ I) och PtSi/TiW/TiW(N)/TiW/Au (typ II) och till dessa relaterade förfarande. Med dessa metalliseringssystem och med detta förfarande kan man utföra IC-sammankopplingar, i vilka metallavståndet är så litet som 1,5 µm eller t.o.m. mindre. Dessa metalliserinssystem är pålitliga i samband med kontinuerliga operationer utförda vid höga temperaturer och stark ström.

